

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005年2月10日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/013601 A1

(51) 国際特許分類: H04N 1/38, 1/387

中町番倉 635 日産化学工業株式会社富山研究開発センター内 Toyama (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010939

(22) 国際出願日: 2004年7月30日 (30.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2003-282738 2003年7月30日 (30.07.2003) JP  
特願2003-345476 2003年10月3日 (03.10.2003) JP

(71) 出願人 (本国を除く全ての指定国について): 日産化学工業株式会社 (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒1010054 東京都千代田区神田豊町3丁目7番地1 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (本国についてのみ): 竹井 敏 (TAKELI, Satoshi) [JP/JP]; 〒9392753 富山県富山郡中町番倉 635 日産化学工業株式会社富山研究開発センター内 Toyama (JP). 岸岡 高広 (KISHIOKA, Takahiro) [JP/JP]; 〒9392753 富山県富山郡中町番倉 635 日産化学工業株式会社富山研究開発センター内 Toyama (JP). 坂田 康志 (SAKAIDA, Yasushi) [JP/JP]; 〒9392753 富山県富山郡中町番倉 635 日産化学工業株式会社富山研究開発センター内 Toyama (JP). 新堀 徹也 (SHINJO, Tetsuya) [JP/JP]; 〒9392753 富山県富山郡中町番倉 635 日産化学工業株式会社富山研究開発センター内 Toyama (JP).

(74) 代理人: 尊 優夫, 外 (HANABUSA, Tsuneo et al.); 〒1010062 東京都千代田区神田駿河台3丁目2番地 新御茶ノ水アーバントリニティ 専任特許事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COMPOSITION FOR FORMING LOWER LAYER FILM FOR LITHOGRAPHY COMPRISING COMPOUND HAVING PROTECTED CARBOXYL GROUP

(54) 発明の名称: 保護されたカルボキシル基を有する化合物を含むリソグラフィー用下層膜形成組成物

(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide a composition for forming a lower layer film for lithography for use in a lithography process for the manufacture of a semiconductor device, and a lower layer film which exhibits an etching rate greater than that of a photoresist and does not cause the intermixing with a photoresist. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] A composition for forming a lower layer film comprising a compound having a protected carboxyl group, a compound having a group capable of reacting with a carboxyl group and a solvent, or comprising a compound having a group capable of reacting with a carboxyl group and a protected carboxyl group and a solvent.

(57) 要約: 【課題】 半導体装置製造のリソグラフィープロセスに使用される、リソグラフィー用下層膜形成組成物、及びフォトリソグリスに比べて大きなドライエッチング速度を有し、そして、フォトリソグリスとのインターミキシングを促さない下層膜を形成すること。【解決手段】 保護されたカルボキシル基を有する化合物、カルボキシル基と反応可能な基を有する化合物及び溶剤を含む下層膜形成組成物、またはカルボキシル基と反応可能な基と保護されたカルボキシル基とを有する化合物及び溶剤を含む下層膜形成組成物。

BEST AVAILABLE COPY

WO 2005/013601 A1